Структура и динамика чистых и смешанных флюоритов MeF_2 (Me = Ca, Sr, Ba, Pb)

© А.Е. Никифоров, А.Ю. Захаров, В.А. Чернышев, М.Ю. Угрюмов, С.В. Котоманов

Уральский государственный университет, 620083 Екатеринбург, Россия

E-mail: Vladimir.Chernyshev@usu.ru

В рамках оболочечной модели в приближении парных потенциалов рассчитаны структура и динамика кристаллической решетки MeF₂ (Me = Ca, Sr, Ba, Pb) под влиянием внешнего гидростатического сжатия (0-3.5 GPa). В этих кристаллах изучен структурный фазовый переход первого рода из кубической в орторомбическую фазу под воздействием давления. Исследовано влияние химического давления на кристалл BaF₂ посредством моделирования смешанных кристаллов Ba_{1-x}Ca_xF₂ и Ba_{1-x}Sr_xF₂. Как показали расчеты, метод суперьячеек при моделировании смешанных кристаллов дает более низкое значение энергии на формульную единицу, чем метод виртуального кристалла.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Минобразования E00-3.4-227 и гранта REC-005 (CRDF).

Интерес к исследованию флюоритов обусловлен широким применением этих материалов в различных областях физики и техники. Флюориты используются в качестве твердого электролита в электрических батареях [1], а также как оптические материалы [2,3]. Особое внимание к изучению флюоритов связано с использованием этих кристаллов с примесями ионов редкоземельных металлов (P3M) в сцинтилляторах. Физика процессов, происходящих в возбужденных состояниях примесных центров в кристаллах, требует знания электронфононного взаимодействия, определяющего время высвечивания ловушек [3].

Некоторые флюориты (PbF₂ и BaF₂) существуют в двух фазах (кубической β -фазе и орторомбической α -фазе), которые можно переводить друг в друга с помощью внешнего давления и температуры. При этом кубическая β -фаза PbF₂ является метастабильной. Исследование этого фазового перехода представляет практический интерес, так как подобный фазовый переход может произойти в эпитаксиальных пленках фторидов щелочно-земельных металлов (ЩЗМ) при различии коэффициентов теплового расширения пленки и подложки [4]. Поэтому актуальными являются оценка критического давления фазового перехода и сравнение его со степенью деформации кристаллической структуры флюорита в пленке.

Смешанные кристаллы (твердые растворы) флюоритов используются для изменения положения линий люминесценции в спектре с помощью варьирования концентрации примеси [5]. Посредством изменения концентрации примеси можно менять структуру примесного центра (например, величина смещения примесного иона меди Cu^{2+} в смешанном кристалле $Ca_xSr_{1-x}F_2:Cu^{2+}$ зависит от концентрации x [6]).

Исследованию структуры и динамики кристаллической решетки флюоритов посвящен ряд теоретических работ. Первые расчеты структуры и динамики примесных РЗМ-ионов во флюоритах были выполнены в работах [7–9]. Один из первых расчетов структуры ЩЗМфлюоритов с дефектами в рамках оболочечной модели был проведен в [10]. Однако изучению орторомбической α -фазы флюоритов посвящено мало работ. В [11] осуществлено экспериментальное и теоретическое исследование фононного спектра орторомбической фазы PbF₂, фононный спектр этой фазы в Г-точке был рассчитан в рамках модели жестких ионов. В настоящее время отсутствует моделирование структурного фазового перехода из кубической в орторомбическую фазу во флюоритах под воздействием гидростатического давления, а также моделирование фононного спектра α -фазы флюоритов в оболочечной модели. Кроме того, отсутствуют работы по моделированию смешанных кристаллов и расчету их фононного спектра.

Данная работа посвящена моделированию структурного фазового перехода из кубической в орторомбическую фазу во флюоритах под воздействием внешнего гидростатического сжатия, а также моделированию смешанных флюоритов в рамках оболочечной модели.

1. Модель расчета энергии кристалла

Параметры равновесной кристаллической структуры при воздействии внешнего гидростатического давления могут быть найдены путем минимизации энтальпии кристалла H = E + PV (где E — энергия кристаллической решетки, P — внешнее гидростатическое давление, V объем элементарной ячейки кристалла). В оболочечной модели в приближении парных потенциалов энергия кристаллической решетки записывается в виде

$$E_{\text{lat}} = \frac{1}{2} \sum_{i,j,j \neq j} V_{i,j} + \frac{1}{2} \sum_{i} k_i |\mathbf{s}_i|^2, \qquad (1)$$

где индекс *i* пробегает по всем ионам элементарной ячейки, а индекс *j* — по всем ионам кристалла, *k_i* —



Рис. 1. Зависимость энергии элементарной ячейки PbF₂ от давления.

константа взаимодействия остов-оболочка, \mathbf{s}_i — смещение оболочки *i*-го иона относительно остова. Парный потенциал межионного взаимодействия $V_{i,j}$ имеет вид

$$V_{ik} = \frac{X_i X_j}{r} + \frac{Y_i X_j}{|\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{s}_i|} + \frac{X_i Y_j}{|\mathbf{r}_{ij} + \mathbf{s}_j|} + \frac{Y_i Y_j}{|\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{s}_i + \mathbf{s}_j|} + C_{ij} \exp(-D_{ij}|\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{s}_i + \mathbf{s}_j|) - \lambda_{ij}/|\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{s}_i + \mathbf{s}_j|^6 + f_{ij}(r), \qquad (2)$$

где X_i, Y_i — заряды остова и оболочки *i*-го иона соответственно $(Z_i = X_i + Y_i), r = |\mathbf{r}_{ij}|$ — расстояние между ядрами ионов. Выражение

$$f_{ij}(r) = -A_{ij} \exp(-B_{ij}r)/r \tag{3}$$

описывает близкодействующую экранировку электростатического взаимодействия остовов ионов, а функция

$$C_{ij} \exp(-D_{ij}|\mathbf{r}_{ij}-\mathbf{s}_i+\mathbf{s}_j|) - \lambda_{ij} / |\mathbf{r}_{ij}-\mathbf{s}_i+\mathbf{s}_j|^6$$
 —

близкодействующее отталкивание между оболочками ионов, записанное в форме потенциала Борна–Майера, и взаимодействие Ван-дер-Ваальса. Параметры взаимодействия ($C_{ij}, D_{ij}, \lambda_{ij}, k_i, A_{ij}, B_{ij}$) и методы их получения приведены в предыдущих работах [12,13].

2. Результаты и обсуждение

2.1. Структурный фазовый переход под воздействием давления. Кристаллы PbF₂ и BaF₂, как уже отмечалось, существуют в кубической фазе (пространственная группа O_h^5) — так называемой β-фазе — или в орторомбической фазе (пространственная группа D_{2h}^{16}) — так называемой α -фазе. Орторомбическая фаза характеризуется более высокой плотностью, более высоким координационным числом (9 в а-фазе и 8 в β -фазе). Примитивная ячейка в β -фазе содержит четыре формульные единицы. При критическом давлении Р_с происходит структурный фазовый переход из β- в α-фазу. При еще более высоких давлениях в этих кристаллах происходит структурный фазовый переход в еще более низкосимметричную фазу с еще более плотной упаковкой [14,15]. В результате наших расчетов была получена зависимость энергии элементарной ячейки от давления для обеих фаз (рис. 1, 2). Аналогичный фазовый переход также предсказан нами в кристаллах CaF2 и SrF2. Результаты расчетов в сравнении с экспериментальными данными приведены в табл. 1. Зависимости параметров кристаллической решетки и объема элементарной ячейки от давления для обеих фаз приведены на рис. 3-7. Нелинейность в зависимости объема элементарной ячейки от давления в орторомбической фазе можно связать с более плотной



Рис. 2. Зависимость энергии элементарной ячейки BaF₂ от давления.



Рис. 3. Зависимость относительного объема элементарной ячейки BaF₂ от давления. Точки — экспериментальные данные [14].



Рис. 4. Зависимость параметров элементарной ячейки BaF₂ от давления. Точки — экспериментальные данные [14].



Рис. 5. Зависимость параметров элементарной ячейки PbF₂ от давления.



Рис. 6. Зависимость относительного объема элементарной ячейки PbF₂ от давления.



Ð

0.86 0 2 4 6 8 10 Pressure, GPa Рис. 7. Зависимость относительного объема элементарной

1.00

0.98

0.96

0.94

0.92

0.90

0.88

Selative volume

·

Рис. 7. Зависимость относительного объема элементарной ячейки орторомбической фазы PbF₂ от давления. Точки — экспериментальные данные [15].

структурой этой фазы и более сильным короткодействующим взаимодействием. При фазовом переходе из β - в α -фазу в исследуемых кристаллах MeF₂ (Me = Ca, Sr, Ba, Pb) происходит уменьшение объема, приходящегося на одну формульную единицу, на 3.3–3.5%. Данный фазовый переход является фазовым переходом первого рода. Изменение объема элементарной ячейки β -фазы этих кристаллов при давлении, соответствующем давлению фазового перехода, приведено в табл. 1. Как видно из этой таблицы, изменение объема элементарной

Таблица 1. Критическое давление P_c и соответствующее ему изменение объема β -фазы кристаллов MeF₂ (Me = Ca, Sr, Ba, Pb)

Кристалл	P_c , GPa		Изменение объема при <i>P_c</i> ,%	Изменение объема в эпи- таксиальной
	Расчет	Эксперимент	Расчет	пленке [4],%
BaF ₂	2.5	2.6 [14]	3.36	
PbF ₂	1.3	0.48 [16]	1.84	
SrF_2	3.0		3.31	
CaF_2	2.9		2.67	2.40

ячейки эпитаксиальной пленки CaF₂ под воздействием кремниевой подложки близко к изменению объема, соответствующему давлению фазового перехода.

2.2. Изменение фононного спектра кристаллов ВаF₂ и РbF₂ под влиянием давления. Исследуемые кристаллы MeF_2 (Me = Ca, Sr, Ba, Pb) являются суперионными проводниками [1,17]. В этих кристаллах при температуре выше критической происходит разупорядочение анионной подрешетки. В фононном спектре кубической фазы кристаллов присутствуют моды, в которых участвуют только анионы (F_{2g}-мода, активная в комбинационном рассеянии), и моды, в которых участвуют как катионы, так и анионы (дипольно-активная F_{1u}-мода). Исследования фононного спектра флюоритов проводятся довольно давно [16,18]. Согласно экспериментальным данным [17], в ряду кристаллов MeF_2 (Me = Ca, Sr, Ba, Pb) температура перехода в суперионное состояние пропорциональна частоте F_{1u} -моды. Влияние давления на суперионную проводимость связано с изменением частоты фононов, определяющей процесс активационного перескока [19]. Нами была исследована зависимость частот F2g- и F1u-мод в Г-точке от гидростатического давления (рис. 8–10). Как видно из расчетов, частоты фононных мод увеличиваются с давлением. Поэтому можно предположить, что под воздействием давления температура перехода в суперионное состояние в этих кристаллах возрастет.



Рис. 8. Зависимость частоты *F*_{1*u*}-моды от давления.

2.3. Влияние химического давления на кристалл Ва F_2 . Влияние химического давления на кристалл Ва F_2 исследовалось путем моделирования смешанных кристаллов Ва $_{1-x}$ Са $_xF_2$ и Ва $_{1-x}$ Sг $_xF_2$, в которых часть ионов Ва $^{2+}$ изовалентно замещена ионами меньшего радиуса. Расчеты были выполнены двумя методами: методом виртуального кристалла и методом суперъячеек. В рамках метода виртуального кристалла параметры

Таблица 2. Разность значений энергии кристаллической решетки (на формульную единицу), рассчитанных методом суперьячеек и методом виртуального кристалла (meV), для смешанных кристаллов

<i>x</i> ,%	$Ba_{1-x}Ca_xF_2$	$Ba_{1-x}Sr_xF_2$
25 50 75	$-84.7 \\ -127.7 \\ -108.1$	$-28.2 \\ -40.2 \\ -32.5$

парного взаимодействия записываются в виде

$$A_{\text{CaBa-F}}(x) = (1 - x)A_{\text{Ba-F}} + xA_{\text{Ca-F}},$$
 (4)

где A — параметр парного взаимодействия, A_{CaBa} — параметр для узла кристаллической решетки, в котором с вероятностью x находится Ca и с вероятностью (1-x) находится Ba.

Метод суперьячеек заключается в замене части ионов данного сорта в элементарной ячейке кристалла ионами другого сорта. Поскольку при этом теряется трансляционная симметрия кристалла, элементарную ячейку необходимо увеличить по тем направлениям постоянных решетки, вдоль которых трансляционная симметрия оказалась нарушенной, в такое число раз, чтобы кристалл с расширенной элементарной ячейкой сохранил трансляционную симметрию. Поэтому данный метод можно использовать только для некоторых значений концентрации примеси x, а требование сохранения трансляционной симметрии кристалла не позволяет проводить расчеты для кристаллов с неупорядоченным распределением ионов примеси по кристаллической решетке. В рамках заданной симметрии при данной концентрации примеси зачастую возможно несколько типов распределения ионов примеси в примитивной ячейке кристалла. Все эти типы соответствуют одной величине энергии элементарной ячейки. Нами были проведены расчеты энергии элементарной ячейки смешанного кристалла $Ba_{1-x}Ca_xF_2$ ($Ba_{1-x}Sr_xF_2$) методом виртуального кристалла и методом суперьячеек при концентрациях примеси x = 0.25, 0.5, 0.75. Как показали эти расчеты (табл. 2), метод суперьячеек дает более низкое значение энергии на формульную единицу, чем метод виртуального кристалла.

В заключение можно отметить, что используемая нами для расчета энергии кристалла оболочечная модель в приближении парных потенциалов позволила достаточно хорошо описать структурный фазовый переход в ряде фторидов MeF₂ (Me = Ca, Sr, Ba, Pb), получить фононный спектр этих кристаллов под давлением, а также смоделировать структуру смешанных кристаллов $Ba_{1-x}Ca_xF_2$ и $Ba_{1-x}Sr_xF_2$. Согласно нашим расчетам, в кристаллах PbF₂ и BaF₂ при структурном фазовом переходе из β - в α -фазу объем, приходящийся на одну формульную единицу, уменьшился на 3.5%. Предска-



Рис. 9. Зависимость частоты *F*_{2g}-моды от давления в кубической фазе PbF₂.



Рис. 10. Зависимость частоты F_{2g} -моды от давления в кубической фазе BaF₂. Точки — экспериментальные данные [16].

зан аналогичный фазовый переход в кристаллах CaF_2 и SrF_2 .

Согласно нашим расчетам, метод суперъячеек при моделировании смешанных кристаллов дает более низкое значение энергии кристаллической решетки, чем метод виртуального кристалла.

Список литературы

- [1] Ю.И. Гуревич, Ю.И. Харкац. УФН 136, 4, 693 (1982).
- [2] K. Kawano, R. Nakata. Proc. of the 1st Asia-Pacific EPR/ESR Symp. Hong Kong (1997). P. 423.
- [3] C.W.E. van Eijk. 10th Feofilov Symposium on Spectroscopy of Crystals Activated by Rare-Earth Transitional-Metal Ions / Ed. A.I. Ryskin, V.F. Masterov. Proc. SPIE 2706, 158 (1996).
- [4] N.S. Sokolov, N.L. Yakovlev. Ibid. P. 57.
- [5] K. Kawano, H. Akahane, R. Nakata, M. Sumita. J. Allows Compounds 221, 218 (1995).
- [6] В.А. Уланов, М.М. Зарипов, В.А. Шустов, И.И. Фазлижанов. ФТТ 40, 3, 445 (1998).
- [7] Б.З. Малкин. ФТТ 11, 5, 1208 (1969).
- [8] З.И. Иваненко, Б.З. Малкин. ФТТ 11, 7, 1859 (1969).
- [9] Ю.К. Воронько, А.Л. Ларионов, Б.З. Малкин. Опт. и спектр. 40, 1, 86 (1976).
- [10] C.R.A. Catlow. Solid State Phys. 9, 1845 (1976).
- [11] А.В. Баженов, И.С. Смирнова, Т.Н. Фурсова, М.Ю. Максимук, А.Б. Кулаков, И.К. Бдикин. ФТТ 42, 1, 40 (2000).
- [12] А.Е. Никифоров, С.Ю. Шашкин. Спектроскопия кристаллов. Наука, Л. (1989). С. 274.
- [13] А.Г. Гусев, В.Г. Мазуренко, А.Е. Никифоров, С.Ю. Шашкин. ФТТ 36, 5, 1437 (1994).
- [14] J.M. Leger, J. Haines, A. Atouf, O. Schulte. Phys. Rev. B52, 18, 13 247 (1995).
- [15] J. Haines, J.M. Leger, O. Schulite. Phys. Rev. B57, 13, 7551 (1998).
- [16] J.R. Kessler, E. Monberg, M. Nikol. J. Chem. Phys. 60, 12, 5057 (1974).
- [17] Физика суперионных проводников / Под ред. М.В. Саламона. Зинатне, Рига (1982). 315 с.
- [18] R.J. Elliott, W. Hayes, W.G. Kleppmann, A.J. Rushworth, J.F. Ryan. Proc. Roy. Soc. (Lond.) A360, 317 (1978).
- [19] P.C. Allen, D. Lazarus. Phys. Rev. B17, 4, 1913 (1978).